

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage	$T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor Dauergleichstrom DC collector current	$T_c= 80^{\circ}\text{C}$ $T_c= 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C, nom}$ I_C	35 55	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p= 1\text{ms}, T_c= 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	70	A
Gesamt Verlustleistung total power dissipation	$T_c= 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	200	W
Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage		V_{GES}	± 20	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	35	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p= 1\text{ms}$	I_{FRM}	70	A
Grenzlastintegral I^2t value	$V_R= 0\text{V}, t_p= 10\text{ms}, T_{vj}= 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	300	A^2s
Isolations Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f= 50\text{Hz}, t= 1\text{min}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter saturation voltage	$V_{GE}= 15\text{V}, T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}, I_C= I_{C, nom}$	V_{CESat}	-	1,7	2,15	V
	$V_{GE}= 15\text{V}, T_{vj}= 125^{\circ}\text{C}, I_C= I_{C, nom}$		-	2,0	-	V
Gate Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE}= V_{GE}, T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}, I_C= 1,5\text{mA}$	$V_{GE(th)}$	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE}= -15\text{V}...+15\text{V}$	Q_G	-	0,33	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f= 1\text{MHz}, T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}, V_{CE}= 25\text{V}, V_{GE}= 0\text{V}$	C_{ies}	-	2,5	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f= 1\text{MHz}, T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}, V_{CE}= 25\text{V}, V_{GE}= 0\text{V}$	C_{fes}	-	0,09	-	nF
Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current	$V_{CE}= 1200\text{V}, V_{GE}= 0\text{V}, T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current	$V_{CE}= 0\text{V}, V_{GE}= 20\text{V}, T_{vj}= 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: M. Münzer

date of publication: 2002-03-04

approved: M. Hierholzer

revision: 3

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{C, nom}$, $V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 25^\circ C$	$t_{d, on}$	-	85	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	90	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{C, nom}$, $V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 25^\circ C$	t_r	-	30	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	45	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{C, nom}$, $V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 25^\circ C$	$t_{d, off}$	-	420	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	520	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{C, nom}$, $V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 25^\circ C$	t_f	-	65	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	90	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse	$I_C = I_{C, nom}$, $V_{CC} = 600V$, $L_\sigma = 70nH$ $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ C$	E_{on}	-	3,5	-	mJ
Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse	$I_C = I_{C, nom}$, $V_{CC} = 600V$, $L_\sigma = 70nH$ $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 27\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ C$	E_{off}	-	4,8	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$t_p \leq 10\mu sec$, $V_{GE} \leq 15V$, $T_{vj} \leq 125^\circ C$ $V_{CC} = 900V$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	140	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	19	-	nH
Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip	$T_c = 25^\circ C$	$R_{CC/EE}$	-	2,5	-	m Ω

Charakteristische Werte / characteristic values

Diode Wechselrichter / diode inverter

Durchlassspannung forward voltage	$I_F = I_{C, nom}$, $V_{GE} = 0V$, $T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,65	2,15	V
	$I_F = I_{C, nom}$, $V_{GE} = 0V$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	1,65	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{C, nom}$, $-di_F/dt = 1500A/\mu s$ $V_R = 600V$, $V_{GE} = -15V$, $T_{vj} = 25^\circ C$	I_{RM}	-	49	-	A
	$V_R = 600V$, $V_{GE} = -15V$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	51	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{C, nom}$, $-di_F/dt = 1500A/\mu s$ $V_R = 600V$, $V_{GE} = -15V$, $T_{vj} = 25^\circ C$	Q_r	-	3,7	-	μC
	$V_R = 600V$, $V_{GE} = -15V$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	6,8	-	μC
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{C, nom}$, $-di_F/dt = 1500A/\mu s$ $V_R = 600V$, $V_{GE} = -15V$, $T_{vj} = 25^\circ C$	E_{rec}	-	1,4	-	mJ
	$V_R = 600V$, $V_{GE} = -15V$, $T_{vj} = 125^\circ C$		-	2,7	-	mJ

Charakteristische Werte / characteristic values

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_c = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_c = 100^\circ\text{C}$, $R_{100} = 493\Omega$	$\Delta R/R$	-5	-	5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}$	P_{25}	-	-	20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp[B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$	-	3375	-	K

Thermische Eigenschaften / thermal properties

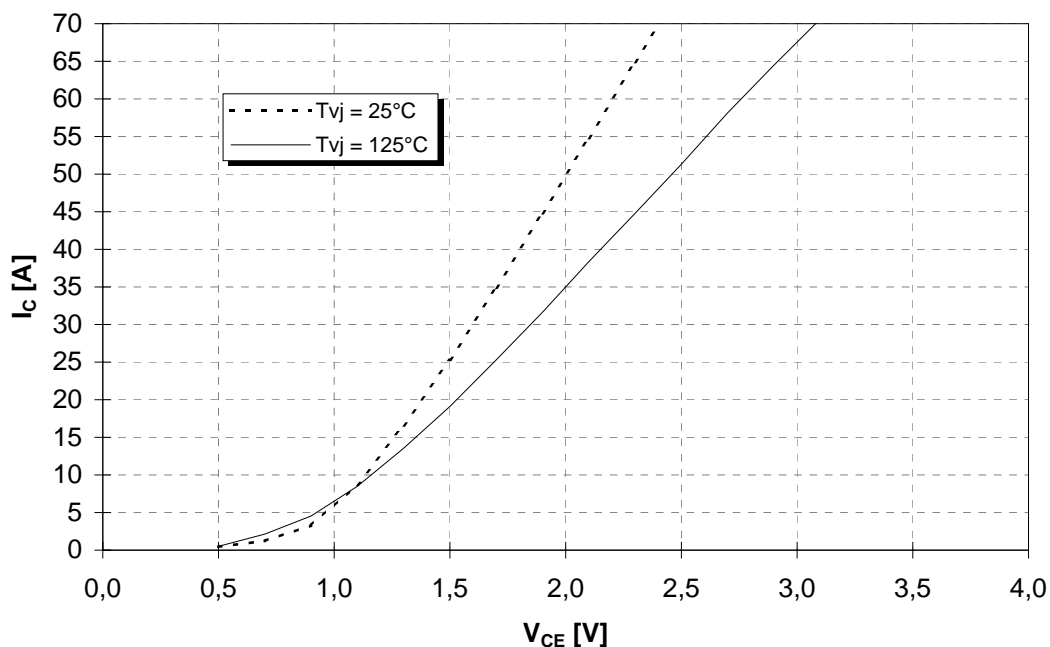
			-	-	0,60	K/W
			-	-	0,95	K/W
Übergangs Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{paste}} = 1\text{W/m}^2\text{K}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature		T_{vjmax}	-	-	150	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operation temperature			-40	-		

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage distance				10		mm
Luftstrecke clearence				7,5		mm
CTI comperative tracking index				225		
	Schraube M 5 screw M 5	M	3	-	6	
Gewicht weight		G		180		g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

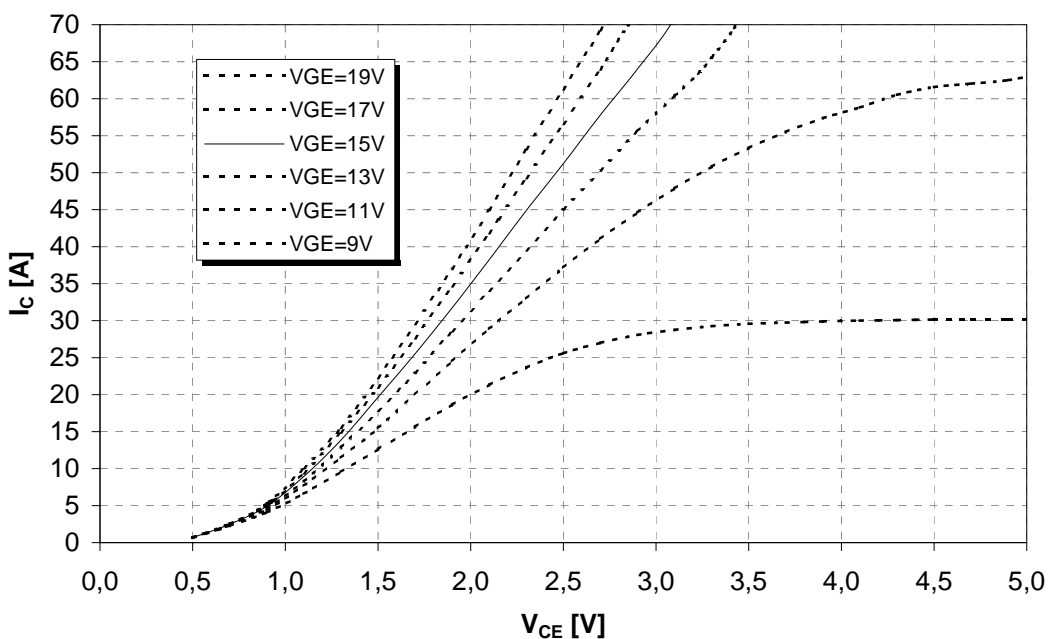
Ausgangskennlinie (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



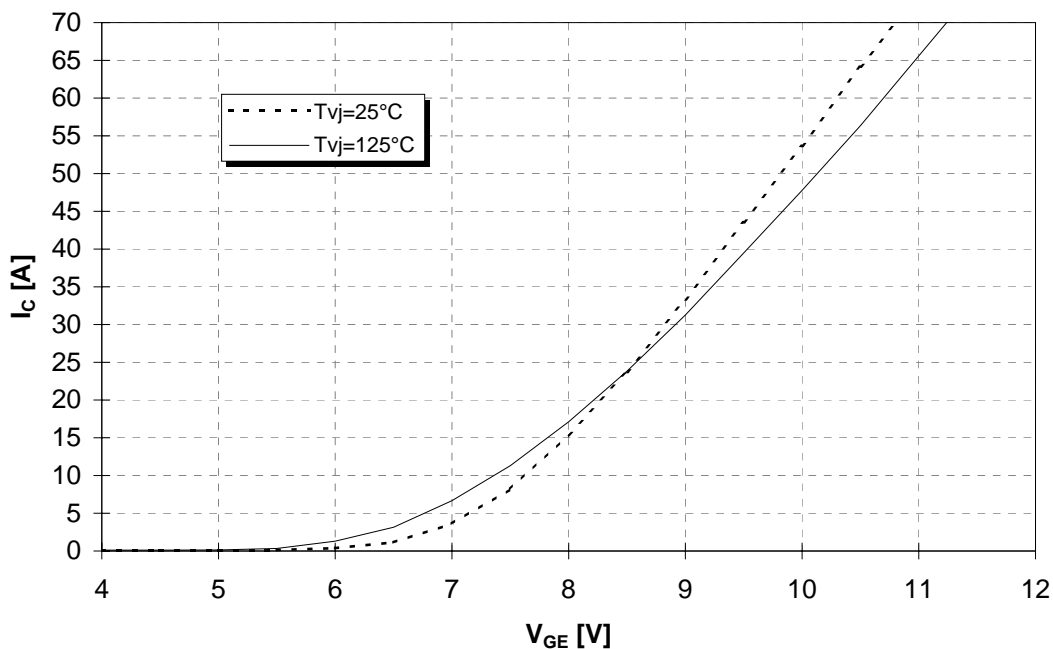
Ausgangskennlinienfeld (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$



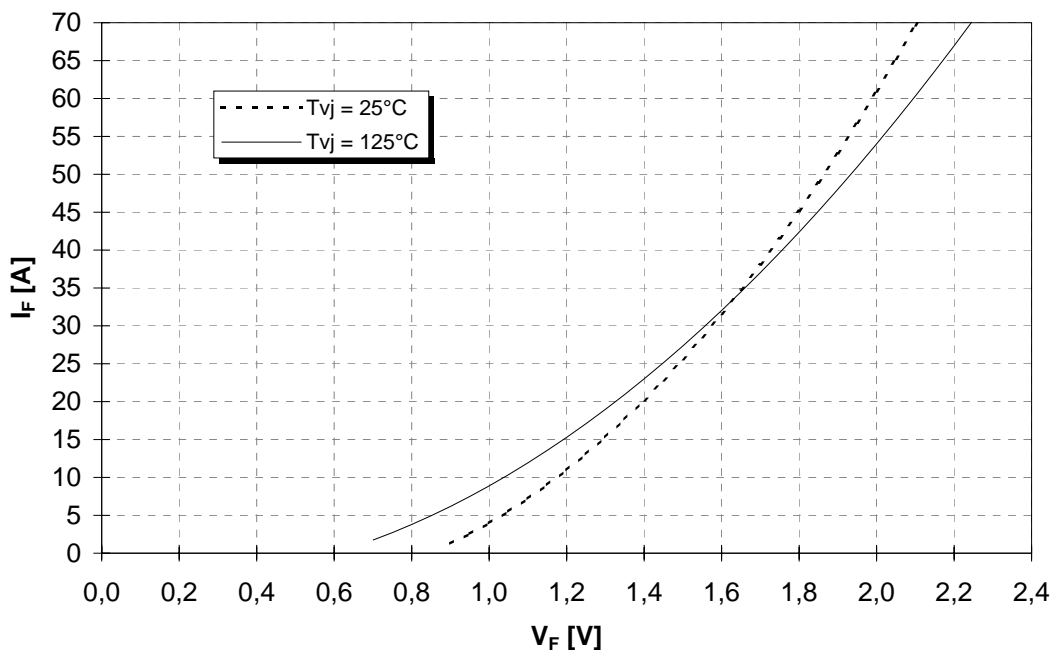
Übertragungscharakteristik (typisch)
transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



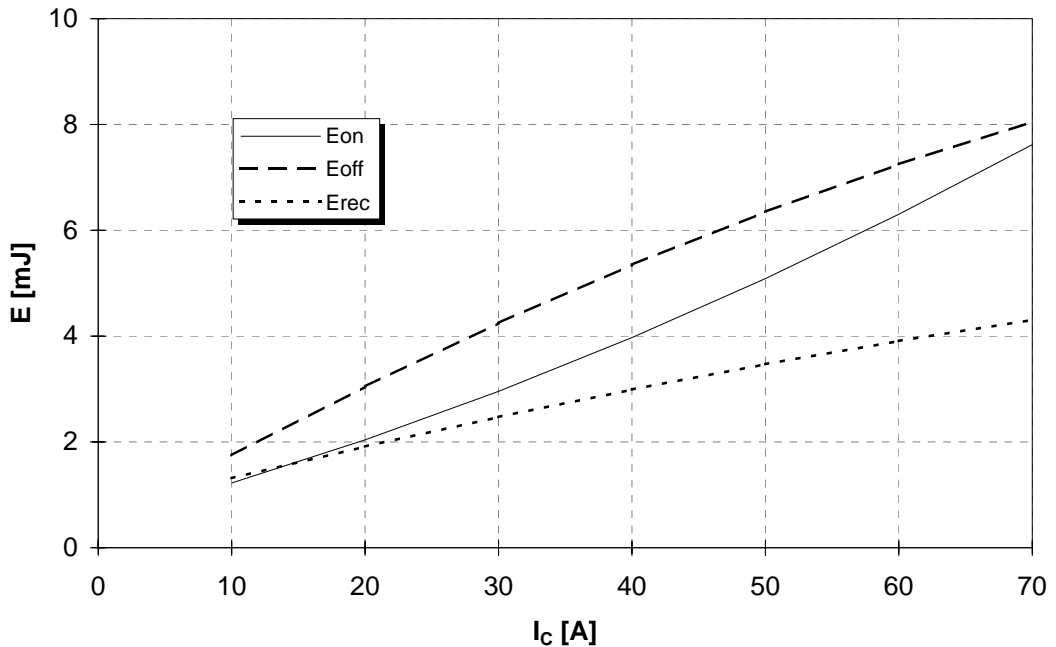
Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch)
forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$



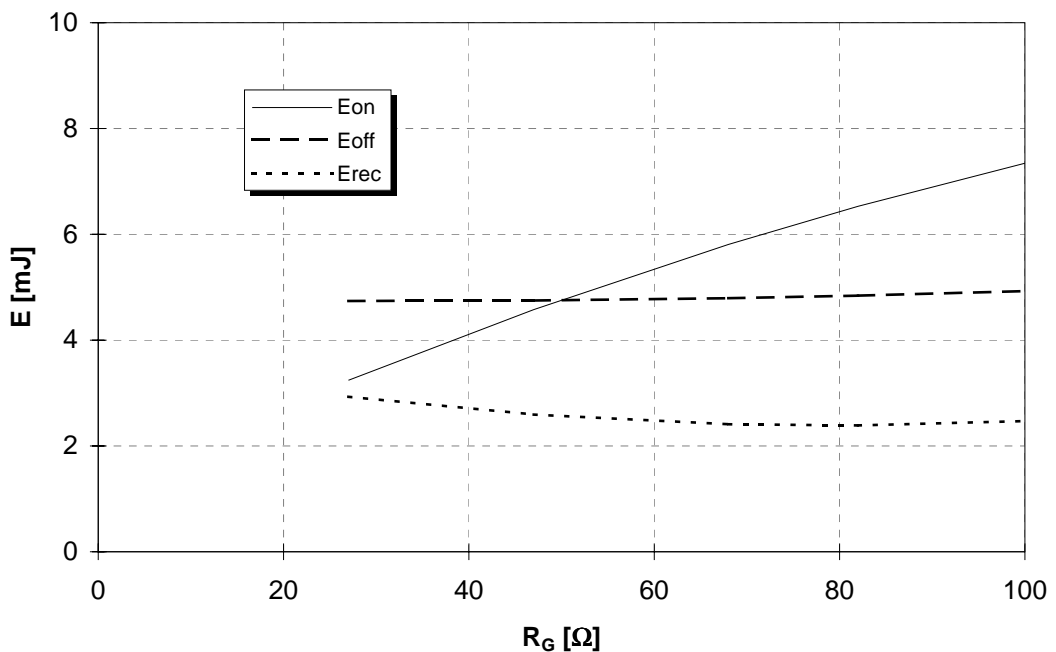
Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 $V_{GE} = 15V$, $R_{Gon} = R_{Goff} = 27\Omega$, $V_{CE} = 600V$, $T_{vi} = 125^\circ C$



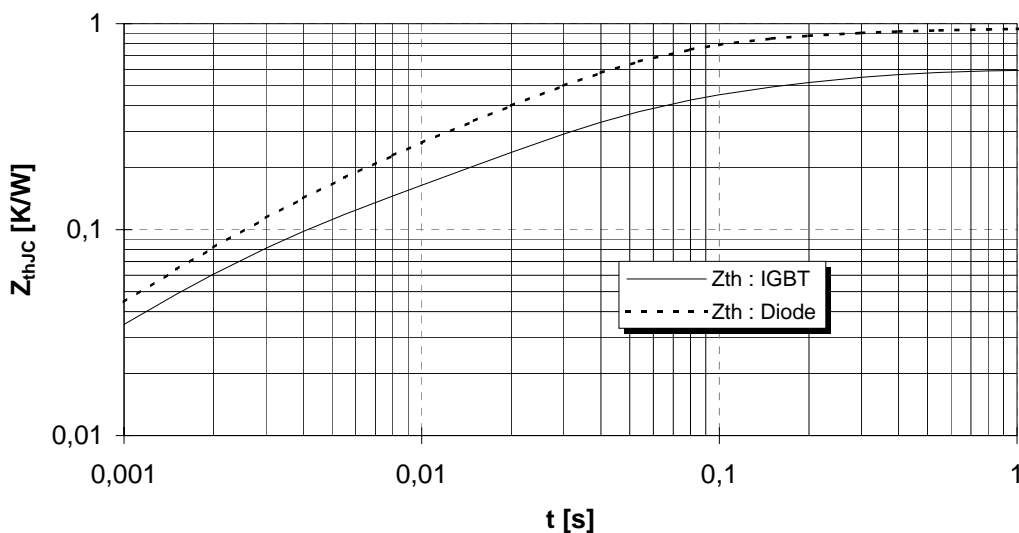
Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{GE} = 15V$, $I_C = 35A$, $V_{CE} = 600V$, $T_{vi} = 125^\circ C$



Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

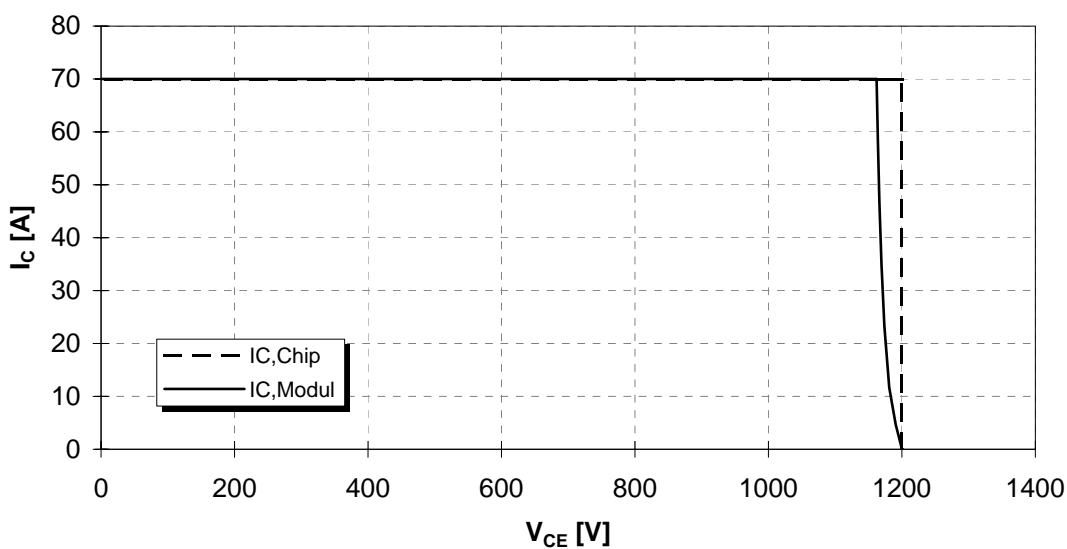
$Z_{thJC} = f(t)$



i	1	2	3	4
r_i [K/W] : IGBT	6,769E-02	1,052E-01	2,709E-01	1,523E-01
τ_i [s] : IGBT	2,345E-03	2,820E-01	2,820E-02	1,128E-01
r_i [K/W] : Diode	9,674E-02	6,249E-01	1,800E-01	5,701E-02
τ_i [s] : Diode	3,333E-03	3,429E-02	1,294E-01	7,662E-01

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA)

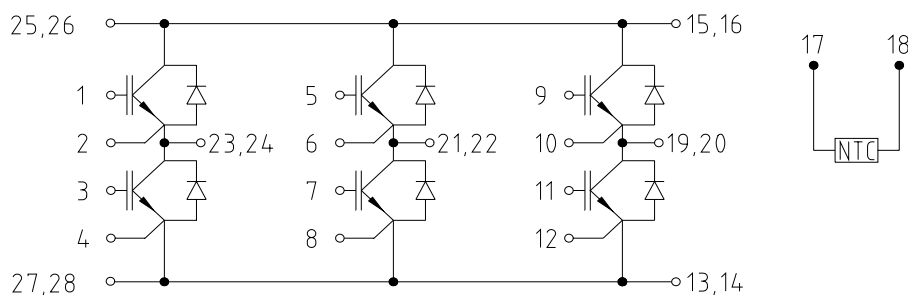
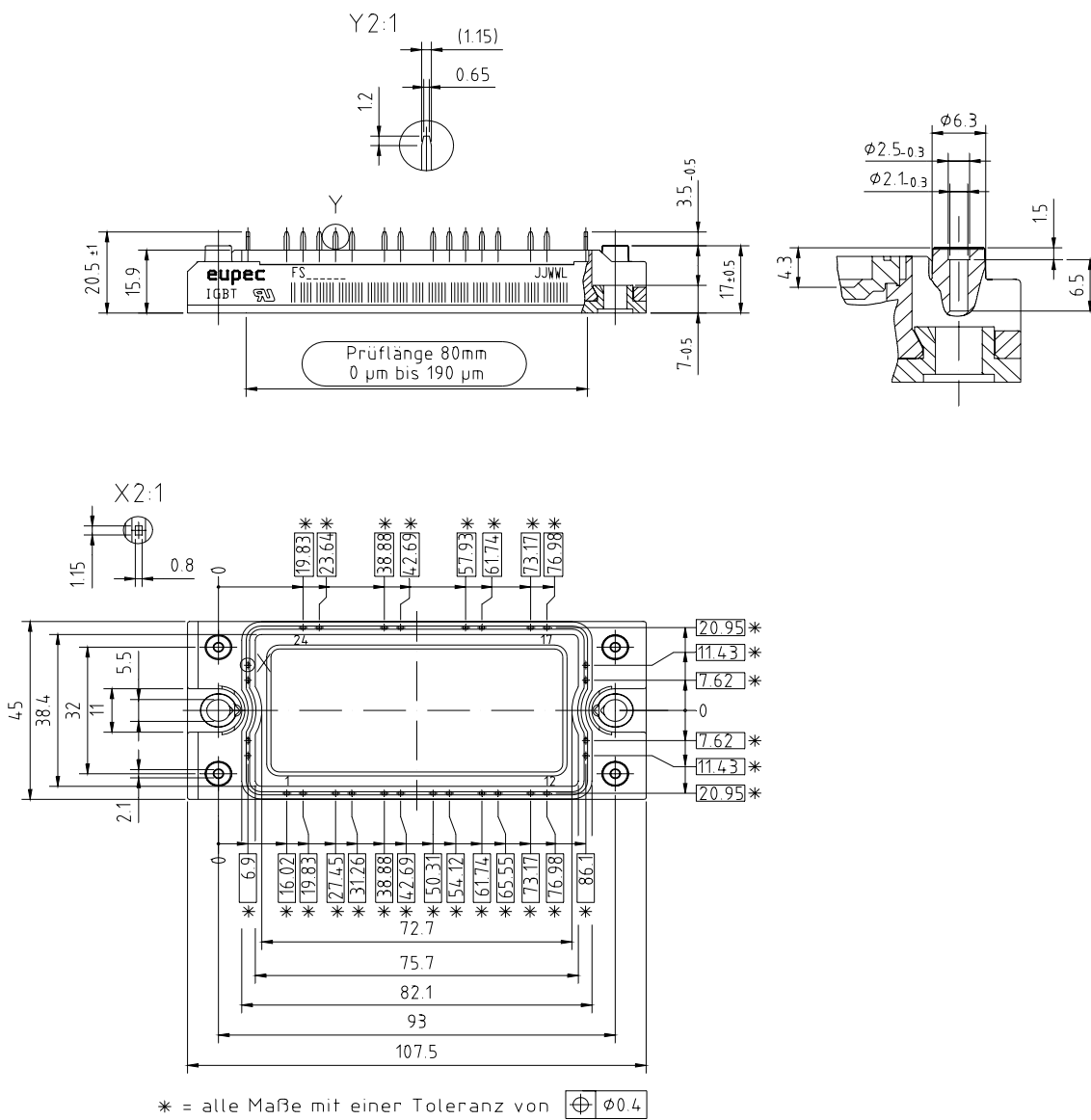
$V_{GE}=15V, R_G=27\Omega, T_i=125^\circ C$



IGBT-Module
IGBT-Modules

FS35R12KE3 G

Gehäusemaße / Schaltbild Package outline / Circuit diagram



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9